

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 2 部門第 1 区分  
 【発行日】平成 26 年 3 月 6 日 (2014.3.6)

【公表番号】特表 2013-505833 (P2013-505833A)  
 【公表日】平成 25 年 2 月 21 日 (2013.2.21)  
 【年通号数】公開・登録公報 2013-009  
 【出願番号】特願 2012-532255 (P2012-532255)  
 【国際特許分類】

**B 0 1 D 53/14 (2006.01)**

**B 0 1 D 53/04 (2006.01)**

**C 1 0 L 3/10 (2006.01)**

【F I】

B 0 1 D 53/14 C

B 0 1 D 53/04 G

C 1 0 L 3/00 B

【誤訳訂正書】  
 【提出日】平成 25 年 12 月 18 日 (2013.12.18)  
 【誤訳訂正 1】  
 【訂正対象書類名】明細書  
 【訂正対象項目名】0 0 0 8  
 【訂正方法】変更  
 【訂正の内容】  
 【0 0 0 8】

最も典型的には、さらなる分子篩床を使用した H<sub>2</sub>S 充填分子篩床を再生するステップの前に、H<sub>2</sub>S を、CO<sub>2</sub> リッチ流から除去し、および / または水を、H<sub>2</sub>S 濃縮 CO<sub>2</sub> 生成物から除去する。H<sub>2</sub>S 濃縮 CO<sub>2</sub> 生成物は、圧縮され、隔離もしくは増強された油回収のための累層または他の好適な場所に再注入されることがさらに一般に好ましい。さらに、CO<sub>2</sub> リッチ流を、H<sub>2</sub>S 充填分子篩床を再生するステップのために加熱することが好ましい。

【誤訳訂正 2】  
 【訂正対象書類名】明細書  
 【訂正対象項目名】0 0 1 0  
 【訂正方法】変更  
 【訂正の内容】  
 【0 0 1 0】

従って、別の角度から見ると、1 ステップにおいて、分子篩床を CO<sub>2</sub> が除去されている処理済み供給ガスと接触させ、このようにして H<sub>2</sub>S 充填分子篩床を形成させる、H<sub>2</sub>S 充填分子篩床を再生する方法が意図される。別のステップにおいて、H<sub>2</sub>S 充填分子篩床を CO<sub>2</sub> と接触させ、これによって分子篩床を再生し、また H<sub>2</sub>S 濃縮 CO<sub>2</sub> 生成物を形成させる。このような方法において、H<sub>2</sub>S 充填分子篩床と CO<sub>2</sub> とを接触させるステップの前に、H<sub>2</sub>S がさらなる分子篩床を使用して CO<sub>2</sub> から除去されていること、および / または水が凝縮され、H<sub>2</sub>S 濃縮 CO<sub>2</sub> 生成物から除去されることが典型的には好ましい。所望の場合、H<sub>2</sub>S 濃縮 CO<sub>2</sub> 生成物は、累層または他の好適な場所に再注入される。

【誤訳訂正 3】  
 【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

C O 2 および H 2 S を含む供給ガスを処理する方法であって、  
フラッシングされたリーン物理溶媒を使用して、吸収体において供給ガスから C O 2 を除去し、こうして処理済みガスおよびリッチ溶媒を形成させることと、

分子篩床を使用して処理済みガスから H 2 S を除去し、これによって H 2 S 充填分子篩床を形成し、ここで、該分子篩床は前記吸収体と流体的に連結されて、前記吸収体から処理済みガスを受け取ることと、

リッチ溶媒をフラッシングし、フラッシングされたリーン物理溶媒および C O 2 リッチ流を生成することと、

C O 2 リッチ流を使用して H 2 S 充填分子篩床を再生し、これによって H 2 S 濃縮 C O 2 生成物を形成することと  
を含む上記方法。

【請求項 2】

さらなる分子篩床を使用して H 2 S 充填分子篩床を再生するステップの前に、H 2 S を、C O 2 リッチ流から除去する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

H 2 S 濃縮 C O 2 生成物から水を除去するステップをさらに含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

H 2 S 濃縮 C O 2 生成物を圧縮し、累層中に再注入するステップをさらに含む、請求項 3 に記載の方法。

【請求項 5】

H 2 S 充填分子篩床を再生するステップのために、C O 2 リッチ流を加熱するステップをさらに含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 6】

リッチ溶媒をフラッシングするステップが、真空フラッシングのステップを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 7】

リッチ溶媒をフラッシングするステップが、多段階フラッシングに亘って行われ、多段階フラッシングの少なくとも 1 つが、炭化水素濃縮蒸気を生成する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 8】

炭化水素濃縮蒸気を圧縮し、圧縮炭化水素濃縮蒸気と供給ガスとを混合するステップをさらに含む、請求項 7 に記載の方法。

【請求項 9】

C O 2 リッチ流の少なくとも 80 % が、リッチ溶媒を加熱することなくリッチ溶媒から形成される、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 10】

供給ガスを脱水および冷却して凝縮させ、供給ガスから C 5 + 炭化水素を除去する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 11】

H 2 S 充填分子篩床を再生する方法であって、  
分子篩床と、C O 2 が除去されている処理済み供給ガスとを接触させ、こうして H 2 S 充填分子篩床を形成させ、ここで、該処理済み供給ガスが吸収体から提供されることと、  
H 2 S 充填分子篩床と C O 2 とを接触させ、これによって分子篩床を再生し、これによって H 2 S 濃縮 C O 2 生成物を形成させることと

を含む上記方法。

【請求項 1 2】

H<sub>2</sub>S 充填分子篩床とCO<sub>2</sub>とを接触させるステップの前に、H<sub>2</sub>S が、さらなる分子篩床を使用してCO<sub>2</sub>から除去されている、請求項 1 1 に記載の方法。

【請求項 1 3】

H<sub>2</sub>S 濃縮CO<sub>2</sub>生成物から水を凝縮および除去するステップをさらに含む、請求項 1 1 に記載の方法。

【請求項 1 4】

H<sub>2</sub>S 濃縮CO<sub>2</sub>生成物を再注入するステップをさらに含む、請求項 1 1 に記載の方法。

【請求項 1 5】

酸性ガス処理プラントであって、

フラッシングされたリーン物理溶媒を使用して、供給ガスからのCO<sub>2</sub>およびH<sub>2</sub>Sの吸収が可能となるように構成され、これによって処理済みガスおよびリッチ溶媒の生成を可能とする吸収体と、

分子篩床を含み、かつ前記吸収体と流体的に連結して、前記吸収体から処理済み供給ガスを受け取り、かつ処理済みガスからのH<sub>2</sub>Sおよび水の吸着を可能とする第1の容器と、

前記吸収体に連結し、かつ前記リッチ溶媒を受け取り、CO<sub>2</sub>リッチ流およびフラッシングされたリーン溶媒を生成するように構成されたフラッシュ容器と、

H<sub>2</sub>S 充填分子篩床を含み、かつ前記フラッシュ容器と流体的に連結され、CO<sub>2</sub>リッチ流を受け取り、これによってH<sub>2</sub>S 濃縮CO<sub>2</sub>生成物および再生された分子篩床を生成する第2の容器と

を含む、上記酸性ガス処理プラント。

【請求項 1 6】

フラッシュ容器と第2の容器とを流体的に連結し、かつCO<sub>2</sub>リッチ流を加熱できるように構成されたヒーターをさらに含む、請求項 1 5 に記載の酸性ガス処理プラント。

【請求項 1 7】

吸収体とフラッシュ容器とを流体的に連結し、かつ炭化水素再循環流を生成するように構成された中圧フラッシュ容器をさらに含む、請求項 1 5 に記載の酸性ガス処理プラント。

【請求項 1 8】

炭化水素再循環流を供給ガスに結合できるように構成された再循環導管をさらに含む、請求項 1 7 に記載の酸性ガス処理プラント。

【請求項 1 9】

さらなる分子篩床を含み、かつCO<sub>2</sub>リッチ流からH<sub>2</sub>Sを除去するように構成された第3の容器をさらに含む、請求項 1 5 に記載の酸性ガス処理プラント。

【請求項 2 0】

吸収体の上流で流体的に連結され、かつ供給ガスを供給ガスからの水およびC<sub>5</sub> + 炭化水素の凝縮および除去を可能とする温度に冷却するように構成された、冷却機をさらに含む、請求項 1 5 に記載の酸性ガス処理プラント。